

7. LITERATURA

- [1] ZÍMA, J.: Integrované monolitické obvody. Praha, SNTL 1971.
- [2] ILJIN, V.N.: Navrhování elektrických obvodů počítačem. Praha, SNTL 1977.
- [3] ŘÍZEK, S.: Návrh morfologie integrovaných obvodů počítačem. Studie č. 4, ČSAV Praha, Academia 1978.
- [4] NOVÁK, M.: Integrované funkční bloky. Praha, SNTL 1978.
- [5] GULDAN, A. aj.: Unipolárne integrované obvody. Bratislava, Alfa 1980.
- [6] SZÁNTÓ, L.: Automatizácia projektovania integrovaných obvodov. Bratislava, Alfa 1985.
- [7] Aktuality technologie a konstrukce polovodičových součástek TESLA, díl č. 27, DT ČSVTS Ostrava 1990.
- [8] BÁRTA, J.: Osobní sdělení.
- [9] BENEŠ, O.: Identifikace parametrů modelů tranzistorů MOS. Sl. obzor, 41, 1980, č. 8, s. 365-371.
- [10] BENEŠ, O.: Programové prostředky pro navrhování integrovaných obvodů. Sl. obzor, 44, 1983, č. 11, s. 547-551.
- [11] BENEŠ, O.: Zákaznické integrované obvody. Sl. obzor, 46, 1985, č. 12, s. 585-589.
- [12] BRZOBOHATÝ, J. - TOMEŠ, M.: Návrh analogových zákaznických integrovaných obvodů. Sl. obzor, 46, 1985, č. 1, s. 10-18.
- [13] BUDÍNSKÝ, J.: Stav vývoje a výroby magnetických bublinových pamětí. Sl. obzor, 41, 1980, č. 7, s. 341-348.
- [14] BUDÍNSKÝ, J.: Vývoj číslicových integrovaných obvodů na GaAs. Sl. obzor, 42, 1981, č. 10, s. 498-502.
- [15] BUDÍNSKÝ, J.: Výzkum možností praktické realizace biočipů. Sl. obzor, 43, 1982, č. 3, s. 147-149.
- [16] BUDÍNSKÝ, J.: Nový pohotovostní zdroj pro mikroelektronické systémy. Sl. obzor, 44, 1983, č. 9, s. 454-457.
- [17] BUDÍNSKÝ, J.: Rychlé číslicové řady CMOS. Sl. obzor, 46, 1985, č. 7, s. 336-342.
- [18] BUDÍNSKÝ, J.: Technologické procesy MOS pro VLSI. Sl. obzor, 46, 1985, č. 9, s. 431-439.
- [19] BUDÍNSKÝ, J.: Možnosti a meze VLSI. Sl. obzor, 47, 1986, č. 4, s. 185-189.
- [20] BUDÍNSKÝ, J.: Laserová metoda výroby integrovaných obvodů. Sl. obzor, 47, 1986, č. 11-12, s. 573.
- [21] BUDÍNSKÝ, J.: Vývoj velmi rychlých tranzistorů MODFET. Sl. obzor, 48, 1987, č. 2, s. 89-92.
- [22] CETKOVSKÝ, J.: Problematika velkopřůměrových křemíkových desek. Sl. obzor, 47, 1986, č. 2, s. 363-364.
- [23] CETKOVSKÝ, J.: Problémy pouzření složitých integrovaných obvodů. Sdělovací technika, 1986, č. 9, s. 338-339.
- [24] CETKOVSKÝ, J.: Snížení napájecího napětí integrovaných obvodů. Sdělovací technika, 1987, č. 12, s. 462-463.
- [25] CETKOVSKÝ, J. - MICHÁLEK, L.: Stav a výhledy mikroelektronické součástkové základny. ODIS VTEI, TESLA VÚST A.S. Popova, Praha 1990.
- [26] CSABAY, O. - HULÉNYI, L. - WEBER, B.: Polovodičové prvky a obvody. Příručka. Časť I. Skriptum EF SVŠT, Ed. str. SVŠT, Bratislava 1981.
- [27] CSABAY, O.: Integrované obvody I. Časť I. Fyzikálne problémy unipolárnych štruktúr. Skriptum EF SVŠT, Ed. str. SVŠT, Bratislava 1987.

- [28] DĚDOUREK, V. - PALATA, J. - PEJČOCH, J.: Identifikace statických parametrů transportního Ebersova-Mollova modelu tranzistoru. Sl. obzor, 42, 1981, č. 7, s. 329-332.
- [29] DEMEL, V. - JÁNEK, F.: Osobní sdělení.
- [30] DOBEŠ, J.: Analýza vícerozměrných dynamických modelů polovodičových struktur. Sl. obzor, 47, 1986, č. 7, s. 318-323.
- [31] DOLEŽAL, V. - RICHVALSKÝ, J. - CZÓKOLY, G.: Realizácia tranzistorov s krátkym kanálom v technológiach NMOS. Sl. obzor, 48, 1987, č. 6, s. 261-268.
- [32] DVORÁK, V.: Modelování obvodů s Josephsonovými přechody. Sl. obzor, 43, 1982, č. 4, s. 169-176.
- [33] GULDAN, A.: Miniaturizácia a mikrominiaturizácia elektronických zariadení. Sdělovací technika, 11, 1963, č. 3, s. 86-89.
- [34] GULDAN, A.: Vytváranie mikroelektronických štruktúr suchým leptaním. Sl. obzor, 42, 1981, č. 1, s. 31-34.
- [35] GULDAN, A.: Plazmové leptacie zariadenie pre mikroelektroniku. Sl. obzor, 42, 1981, č. 5, s. 247-250.
- [36] FRANTA, V.: Simulace teplotního pole v monolitickém integrovaném obvodu metodou Monte Carlo. Sl. obzor, 38, 1977, č. 9, s. 441-442.
- [37] HAMERNÍK, J. - KADAŇKA, P.: Osobní sdělení.
- [38] HOFF, F.: Uplatnění molekulárních epitaxních technologií. Sl. obzor, 48, 1987, č. 7, s. 339-340.
- [39] Hf: Epitaxní technologie pro elektroniku. Sl. obzor, 48, 1987, č. 12, s. 577-579.
- [40] HOFF, F.: Základní metody a přístroje pro studium a analýzu povrchů. Sl. obzor, 49, 1988, č. 2, s. 81-85.
- [41] Hf: Optické spoje integrovaných obvodů. Sl. obzor, 49, 1988, č. 4, s. 192.
- [42] HONOMICHL, V.: Rozbor odvodu tepla z integrovaných obvodů velké integrace. Sl. obzor, 46, 1985, č. 8, s. 388-389.
- [43] HONOMICHL, V.: Integrovaní chlazení integrovaných obvodů s velkým ztrátovým výkonem. Sl. obzor, 46, 1985, č. 12, s. 596-598.
- [44] HRUŠKA, J.: Geometrické parametry číslicových integrovaných obvodů budoucnosti. Sl. obzor, 49, 1988, č. 10, s. 503-504.
- [45] CHMEL, J. aj.: Řešení číslicových integrovaných obvodů na GaAs pomocí hradlového pole. Sl. obzor, 48, 1987, č. 8, s. 360-364.
- [46] CHMEL, J. aj.: Logické obvody SDFL z arzenidu galitého. Sl. obzor, 48, 1987, s. 529-533.
- [47] KODEŠ, J.: Balistický transport elektronů. Sl. obzor, 45, 1984, č. 9, s. 424-426.
- [48] KODEŠ, J. - SAMEK, J.: Experimentální submikronové struktury. Sl. obzor, 48, 1987, č. 3, s. 111-115.
- [49] KRÍVOHLÁVEK, J.: Dvoudimenzionální model tranzistoru MESFET na bázi GaAs. Sl. Obzor, 45, 1984, č. 7, s. 306-313.
- [50] KRÍVOHLÁVEK, J.: Jednorozměrný matematický model bipolárního tranzistoru. Sl. obzor, 47, 1986, č. 11-12, s. 548-554.
- [51] KRÍVOHLÁVEK, J.: Jednorozměrný stacionární model diody a tranzistoru. Sl. obzor, 48, 1987, č. 8, s. 374-379.
- [52] LAIPERT, M. - KADLEC, J. - MARTINEK, P.: Rozbor vlastností dvojité vyváženého modulátoru. Sl. obzor, 44, 1983, č. 2, s. 60-65.
- [53] MALINA, V.: Molekulární epitaxe - perspektivní metoda přípravy polovodičových součástek. Sl. obzor, 39, 1978, č. 3, s. 93-100.
- [54] MATYS, J.: Metody optimálního nastavení technologických veličin při výrobě čipů integrovaných obvodů. Sl. obzor, 45, 1984, č. 6, s. 273-277.

- [83] HORÁK, M.: Studium polovodičových křemíkových struktur metodou Monte Carlo. In: Knižnice odborných a vědeckých spisů VUT v Brně, roč. 1987, sv. A-33, s. 5-63.
- [84] HORÁK, M.: Výpočet transportních koeficientů v křemíku jednočásticovou metodou Monte Carlo. In: Knižnice odborných a vědeckých spisů VUT v Brně, sv. B-114, s. 35-38.
- [85] HORÁK, M.: Metoda Monte Carlo a její využití pro modelování submikrometrových polovodičových struktur. In: Knižnice odborných a vědeckých spisů VUT v Brně, sv. B-114, s. 147-150.
- [86] SELBERHERR, S.: Analysis and simulation of semiconductor devices. Springer Verlag, Wien - New York 1984.
- [87] NEUSCHL, Š. aj.: Modelovanie a simulácia. Bratislava, Alfa/SNTL 1988.
- [88] MANN, H.: Teorie strojních soustav II. Skriptum VUT FS. Ed. stř. VUT, 1990.
- [89] GUMMEL, H.K.: IEEE Trans., vol. ED-11, s. 455-465.
- [90] KŘIVOHLÁVEK, J.: Matematické modely polovodičových struktur. Sl. obzor, 1983, č. 3, s. 123-127.
- [91] ENGL, W.L. aj.: Device modeling. Proc. of the IEEE, 1983, vol. 71, č. 1, s. 10-33.
- [92] EBERS, R.S. - MOLL, J.J.: Large signal behaviour of junction transistors. Proc. IRE, 42, Dec. 1954, s. 1761-1772.
- [93] DOBROTOVÁ, M. - WASYLUK, R.: Přehled technologií integrovaných obvodů. ODIS VTEI, TESLA VÚST A.S. Popova, Praha 1984.
- [94] KREJČIŘÍK, A.: Technologie materiálu - příklady technologií. Skriptum FEL ČVUT, Ed. stř. ČVUT Praha 1986.
- [95] JOHNSON, E.O. - ROSE, A.: Simple general analysis of amplifier devices with emitter control, and collector functions. Proc. IRE, March 1959, s. 407.
- [96] ROSE, A.: An analysis of the gain-bandwidth limitations of solid-state triodes. RCA Review, Dec. 1963, s. 627.
- [97] JOHNSON, E.O.: Physical limitations of frequency and power parameters of transistors. RCA Review, June 1965, s. 163.
- [98] MUSIL, V. a kol.: Technologické procesy a jejich modelování II. Skriptum VUT FE, Ed. stř. VUT, Brno 1990.
- [99] DENNARD, R.H. aj.: Design of ion-implanted MOS-FET's with very small physical dimensions. IEEE J. Solid-State Circuits, vol. SC-9, 1974, č. 5, s. 256-268.
- [100] CETKOVSKÝ, J.: Křemíkové desky velkých průměrů. Sdělovací technika, 1990, č. 3, s. 94.
- [101] ŠVEJKOVSKÝ, R.: Osobní sdělení.
- [102] ČERNOHORSKÝ, D.: Teorie elektromagnetického pole II. Skriptum FE VUT. Ediční středisko VUT, Brno 1986.